

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 12 月 31 日 (31.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/001093 A1

(51) 国際特許分類⁷: C23C 14/34, C22C 5/06, C22F 1/14

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/007909

(22) 国際出願日: 2003 年 6 月 23 日 (23.06.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-183462 2002 年 6 月 24 日 (24.06.2002) JP
特願2002-183463 2002 年 6 月 24 日 (24.06.2002) JP

荒井町 新浜2丁目3番1号 株式会社神戸製鋼所高砂製作所内 Hyogo (JP). 高木 勝寿 (TAKAGI, Katsutoshi) [JP/JP]; 〒651-2271 兵庫県 神戸市西区 高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所神戸技術総合研究所内 Hyogo (JP). 中井 淳一 (NAKAI, Junichi) [JP/JP]; 〒651-2271 兵庫県 神戸市西区 高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内 Hyogo (JP). 中根 靖夫 (NAKANE, Yasuo) [JP/JP]; 〒676-8670 兵庫県 高砂市 荒井町新浜2丁目3番1号 株式会社神戸製鋼所高砂製作所内 Hyogo (JP).

(74) 代理人: 小谷 悦司, 外 (KOTANI, Etsuji et al.); 〒530-0005 大阪府 大阪市北区 中之島2丁目2番2号 ニチメンビル2階 Osaka (JP).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社コベルコ科研 (KOBELCO RESEARCH INSTITUTE, INC.) [JP/JP]; 〒651-0073 兵庫県 神戸市中央区 脇浜海岸通1丁目5番1号 Hyogo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, DE, KR, SG, US.

添付公開書類:
— 国際調査報告書

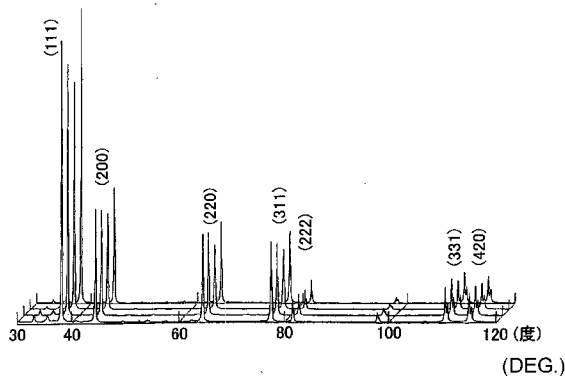
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松崎 均 (MAT-SUZAKI, Hitoshi) [JP/JP]; 〒676-8670 兵庫県 高砂市

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SILVER ALLOY SPUTTERING TARGET AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 銀合金スパッタリングターゲットとその製造方法



(57) Abstract: A silver alloy sputtering target useful for formation of a silver alloy thin film of especially uniform thickness according to sputtering technique, wherein, when crystal orientation intensities are determined at four arbitrary points according to X-ray diffractometry, the direction exhibiting the highest crystal orientation intensity (Xa) is identical at the four measuring points and further the dispersion of intensity ratio (Xb/Xa) between highest crystal orientation intensity (Xa) and second highest crystal orientation intensity (Xb) at each of the measuring points is 20% or less.



(57) 要約:

特に膜厚が均一である銀合金薄膜をスパッタリング法で形成するのに有用な銀合金スパッタリングターゲットであって、任意の4箇所についてX線回折法で結晶配向強度を求めたときの、最も高い結晶配向強度（ X_a ）を示す方位が4測定箇所でも同一であり、かつ各測定箇所における最も高い結晶配向強度（ X_a ）と2番目に高い結晶配向強度（ X_b ）との強度比（ X_b / X_a ）のばらつきが20%以下である銀合金スパッタリングターゲットを提供する。